

10/5/11423

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用）- 印刷日時 2003年04月12日 (12.04.2003) 土曜日 17時57分21秒

pf-3167

1/4

0	受理官庁記入欄 国際出願番号	
0-1	国際出願日	
0-3	（受付印）	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国 際出願願書は、 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.01.2003)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受 理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の番類記号	pf-3167
I	発明の名称	半導体装置およびその製造方法
II	出願人 II-1 この欄に記載した者は II-2 右の指定国についての出願人である。 II-4ja II-4ea II-5ja II-6en II-6 II-7 III-1 III-1-1 III-1-2 III-1-4j III-1-4e III-1-5j III-1-5e III-1-6 III-1-7	出願人である (applicant only) 米国を除くすべての指定国 (all designated States except US) 日本電気株式会社 NEC Corporation 108-8001 日本国 東京都 港区 芝五丁目 7 番 1 号 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 Japan 日本国 JP 日本国 JP 出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only) 渡部 平司 WATANABE, Heiji 108-8001 日本国 東京都 港区 芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株式会社内 c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 Japan 日本国 JP 日本国 JP
III-1-5e	Address:	<i>NEC 03/6068</i>
III-1-6	国籍 (国名)	
III-1-7	住所 (国名)	

BEST AVAILABLE COPY